

Первое извещение

XII Российская конференция по физике полупроводников «Полупроводники-2015» будет проходить с 21 по 25 сентября 2015 года в пансионате "Ершово", г. Звенигород Московской области. Эта конференция продолжит традицию предыдущих конференций, которые были проведены в Нижнем Новгороде (1993, 2001, 2011), Санкт-Петербурге (1996, 2003, 2013), Москве (1997, 2005), Новосибирске (1999), Екатеринбурге (2007), в Новосибирске и Томске (2009).

Сайт конференции

<http://semicond-2015.lebedev.ru/>

Организаторы конференции

- Научный совет по физике полупроводников РАН
- Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук (ФИАН)
- Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН (ИРЭ)
- Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
- Отделение физических наук РАН

Конференцию поддерживают

- Федеральное агентство научных организаций
- Российская академия наук
- Российский фонд фундаментальных исследований
- Фонд некоммерческих программ «Династия»

Тематика конференции

Конференция посвящена фундаментальным проблемам физики полупроводников. Основные разделы программы:

- 1. Объемные полупроводники:** электрические и оптические свойства, релаксация носителей заряда, сверхбыстрые явления, экситоны, фононы, фазовые переходы, упорядочение.
- 2. Поверхность, пленки, слои:** эпитаксия, атомная и электронная структура поверхности, адсорбция и поверхностные реакции, процессы формирования (самоорганизации) нанокластеров, СТМ и АСМ, оптическая микроскопия ближнего поля.
- 3. Гетероструктуры и сверхрешетки:** структурные и оптические свойства, электронный транспорт, микрорезонаторы.
- 4. Двумерные системы:** структурные, электронные, магнитные и оптические свойства, туннелирование, локализация, фононы, плазмоны, квантовый эффект Холла, корреляционные эффекты.
- 5. Одномерные и нульмерные системы:** энергетический спектр, электронный транспорт, оптические свойства, локализация.
- 6. Спиновые явления, спинтроника, наномagnetизм.**
- 7. Примеси и дефекты (объемные полупроводники и квантово-размерные структуры):** примеси с мелкими и глубокими уровнями, магнитные примеси, структурные дефекты, неупорядоченные полупроводники.
- 8. Высокочастотные явления в полупроводниках (СВЧ и терагерцовый диапазон).**
- 9. Органические полупроводники, молекулярные системы.**
- 10. Углеродные наноматериалы.**
- 11. Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанофотоника.**
- 12. Полупроводниковые приборы и устройства: технология, методы исследования, наноприборы.**
- 13. Наномеханика.**
- 14. Топологические изоляторы.**

Программный комитет

Е.Л. Ивченко, *председатель*, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

И.П. Акимченко, *ученый секретарь*, Научный совет по физике полупроводников РАН, Москва

Ж.И. Алферов, СПб АУ НОЦНТ РАН, Санкт-Петербург

А.А. Андронов, ИФМ РАН, Нижний Новгород

А.Л. Асеев, ИФП СО РАН, Новосибирск

В.А. Волков, ИРЭ РАН, Москва

С.В. Гапонов, ИФМ РАН, Нижний Новгород

А.А. Гиппиус, ФИАН, Москва

М.М. Глазов, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

А.А. Горбачевич, ФИАН, Москва

А.В. Двуреченский, ИФП СО РАН, Новосибирск

В.С. Днепровский, МГУ, Москва

А.Г. Забродский, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

С.В. Зайцев-Зотов, ИРЭ РАН, Москва

А.А. Каплянский, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

В.В. Кведер, ИФТТ РАН, Черногоровка

Л.В. Келдыш, ФИАН, Москва

З.Ф. Красильник, ИФМ РАН, Нижний Новгород

И.В. Кукушкин, ИФТТ РАН, Черногоровка

В.Д. Кулаковский, ИФТТ РАН, Черногоровка

Л.В. Кулик, ИФТТ РАН, Черногоровка

Ю.Г. Курсаев, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

П.С. Копьев, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

И.Г. Неизвестный, ИФП СО РАН, Новосибирск

В.И. Окулов, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург

В.Я. Покровский, ИРЭ РАН, Москва

А.А. Саранин, ИАПУ ДВО РАН, Владивосток

Н.Н. Сибельдин, ФИАН, Москва

Р.А. Сурис, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

А.С. Терехов, ИФП СО РАН, Новосибирск

В.Б. Тимофеев, ИФТТ РАН, Черногоровка

В.М. Устинов, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

Д.Р. Хохлов, МГУ, Москва

А.В. Чаплик, ИФП СО РАН, Новосибирск

В.И. Шашкин, ИФМ РАН, Нижний Новгород

Контакты

Москва, 119991, Ленинский проспект, 53,

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,

Акимченко Ирена Петровна — ученый секретарь программного комитета

тел.: 8-499-131-47-52, 8-903-131-46-37

электронная почта: iakimchenko@mail.ru

Место проведения

Пансионат "Ершово", г. Звенигород Московской области. Размещение предполагается в комфортабельных номерах. Будет организовано трехразовое питание и кофейные столы в перерывах между заседаниями.

Регистрация участников

Регистрация участников будет осуществляться только в электронном виде на сайте конференции

<http://semicond-2015.lebedev.ru/>

Организационный комитет

Н.Н. Сибельдин, *председатель*, ФИАН, Москва
А.А. Горбачевич, *заместитель председателя*, ФИАН, Москва
Д.Р. Хохлов, *заместитель председателя*, МГУ, Москва
А.А. Пручкина, *ученый секретарь*, ФИАН, Москва

А.А. Алещенко, ФИАН, Москва
Б.А. Аронзон, НИЦ «КИ» и ФИАН, Москва
Т.М. Бурбаев, ФИАН, Москва
В.А. Волков, ИРЭ РАН, Москва
В.И. Гавриленко, ИФМ РАН, Н. Новгород
А.А. Гиппиус, ФИАН, Москва
А.В. Двуреченский, ИФП СО РАН, Новосибирск
В.А. Дравин, ФИАН, Москва
В.А. Заяц, ОФН РАН
О.А. Клименко, ФИАН, Москва
П.С. Копьев, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
А.В. Кулешов, ФИАН, Москва
И.В. Кучеренко, ФИАН, Москва
Ю.А. Митягин, ФИАН, Москва
В.И. Окулов, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Л.С. Подлесных, ФИАН, Москва
Т.А. Романова, ФИАН, Москва
А.И. Шарков, ФИАН, Москва

Контакты

Москва, 119991, Ленинский проспект, 53,
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,

Алещенко Юрий Анатольевич

тел.: 8-499-132-63-61, 8-499-132-62-93

Пручкина Анна Артемовна - ученый секретарь организационного комитета

тел.: 8-499-132-64-48

Факс: 8-499-135-23-20

Электронная почта: semicond-2015@sci.lebedev.ru

Сайт конференции: <http://semicond-2015.lebedev.ru/>

Представление тезисов докладов

Тезисы докладов, подготовленные в соответствии с инструкцией, должны быть представлены не позднее 23 марта 2015 года на сайте конференции <http://semicond-2015.lebedev.ru/>.

Инструкция по подготовке и представлению тезисов представлена на сайте конференции.

Важные даты

2 февраля 2015 г. Первое извещение;

3 февраля 2015 г. Начало регистрации и подачи тезисов докладов;

23 марта 2015 г. Окончание подачи тезисов докладов;

29 апреля 2015 г. Информация о включении доклада в программу (на сайте конференции);

15 мая 2015 г. Второе извещение;

21 сентября 2015 г. Начало конференции.